北京大学
PEKING UNIVERSITY

光电材料与器件领域专题讲座

2023年第14期

http://icmp.pku.edu.cn/xsjl/gdclyqjlyztjz.htm

GaN LED的发展与新际遇

黄少华 博士、副总裁

时间： 2023年6月1日（星期四） 13:00—14:30

地点： 北京大学物理楼中312会议室

报告人简介（About speaker）：

黄少华博士，2010年4月加入三安光电，主要从事研发项目的工作，研究课题有超大功率垂直发光二级管于特种应用照明，MicroLED芯片项目组组长，三安激光器项目开发组组长；现任三安光电GaN事业部副总以及工程部副部长一职，以及三安美国子公司Luminus Device Inc.技术长一职，长期致力于光电半导体方面相关研究。

摘要（Abstract）：

GaN LED经历了几个关键的技术突破口，从早期的缓冲层，P-型GaN，ITO透明导电膜，图案化衬底到如今的复合衬底，让GaN LED的内部效率以及取光效率都得到了大幅的提升；也让LED的应用越发的广泛，三安光电作为国内LED的龙头生产企业，所覆盖的应用从低端照明到高端的显示（mini，MicroLED）皆有覆盖；透过今天的演讲让大家了解到GaN LED的发展过程以及未来新际遇.

联系人（Host）：陈志忠 zzchen@pku.edu.cn

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理所